

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成24年8月16日(2012.8.16)

【公表番号】特表2011-528383(P2011-528383A)

【公表日】平成23年11月17日(2011.11.17)

【年通号数】公開・登録公報2011-046

【出願番号】特願2011-515441(P2011-515441)

【国際特許分類】

C 0 8 G	61/12	(2006.01)
H 0 1 M	14/00	(2006.01)
G 0 3 G	5/06	(2006.01)
H 0 1 L	51/05	(2006.01)
H 0 1 L	51/30	(2006.01)
H 0 1 L	29/786	(2006.01)

【F I】

C 0 8 G	61/12	
H 0 1 M	14/00	P
G 0 3 G	5/06	3 1 5 B
H 0 1 L	29/28	1 0 0 A
H 0 1 L	29/28	2 5 0 G
H 0 1 L	29/78	6 1 8 B

【手続補正書】

【提出日】平成24年6月28日(2012.6.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

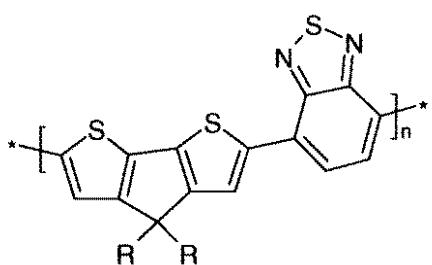
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

式(I)の基

【化1】



(式中、Rはn-ヘキサデシルまたは3,7-ジメチルオクチルである。)

を繰返単位として含み、トリクロロベンゼンを溶離液として使用しポリスチレン標準試薬に対してゲル浸透クロマトグラフィーで求めた数平均分子量Mnが30~70kg/mo1の範囲にあるベンゾチアジアゾール-シクロペンタジチオフェンコポリマー。

【請求項2】

液状媒体中に溶解または分散した請求項1の1種以上のコポリマーを含む組成物。

【請求項3】

請求項 1 の 1 種以上のコポリマーを含む薄膜半導体。

【請求項 4】

基板と、該基板上に設けられた請求項 3 の薄膜半導体とを含む複合体。

【請求項 5】

請求項 1 に記載の 1 種類以上のコポリマーを液状媒体中に溶解して溶液とし、該溶液を支持体上に施与し、溶媒を除いて基板上に薄膜半導体を形成することを特徴とする複合体の製造方法。

【請求項 6】

前記溶液を、回転塗布、浸漬塗布または印刷により施与する請求項 5 に記載の製造方法。

【請求項 7】

請求項 3 の薄膜半導体または請求項 4 の複合体を含む電界効果トランジスタ装置。

【請求項 8】

請求項 3 の薄膜半導体または請求項 4 の複合体を含む光発電装置。

【請求項 9】

請求項 3 の薄膜半導体または請求項 4 の複合体を含む有機発光ダイオード装置。